

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年2月19日(2015.2.19)

【公開番号】特開2013-168620(P2013-168620A)

【公開日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2013-046

【出願番号】特願2012-32635(P2012-32635)

【国際特許分類】

H 01 S 5/16 (2006.01)

【F I】

H 01 S 5/16

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月17日(2014.12.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

まず、図1に示すように、Siをドープしたn型GaAs基板1上に順に、2.8μm厚のAl<sub>0.48</sub>Ga<sub>0.52</sub>Asからなるn型クラッド層2、Al<sub>0.335</sub>Ga<sub>0.665</sub>As(10nm)/Al<sub>0.112</sub>Ga<sub>0.888</sub>As(8.4nm)/Al<sub>0.335</sub>Ga<sub>0.665</sub>As(8.4nm)/Al<sub>0.112</sub>Ga<sub>0.888</sub>As(8.4nm)/Al<sub>0.335</sub>Ga<sub>0.665</sub>As(10nm)からなる量子井戸構造の活性層3、0.165μm厚のAl<sub>0.48</sub>Ga<sub>0.52</sub>Asからなるp型クラッド層4、及び20nm厚のGaAsからなるp型コンタクト層5をMOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)により形成する。